

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2745943

ДАТЧИК ДИОКСИДА АЗОТА

Патентообладатель: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» (RU)**

Авторы: **Кировская Ираида Алексеевна (RU), Уманский Илья Юрьевич (RU), Эккерт Алиса Олеговна (RU), Эккерт Роберт Владимирович (RU), Букашкина Татьяна Леонидовна (RU)**

Заявка № 2020127749

Приоритет изобретения **20 августа 2020 г.**

Дата государственной регистрации

в Государственном реестре изобретений

Российской Федерации **05 апреля 2021 г.**

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает **20 августа 2040 г.**



*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0x02A5CFBC00B1ACF59A40A2F08092E9A118

Владелец **Ивлиев Григорий Петрович**

Действителен с 15.01.2021 по 15.01.2035

Г.П. Ивлиев



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК
G01N 27/125 (2021.02)

(21)(22) Заявка: 2020127749, 20.08.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.08.2020

Дата регистрации:
05.04.2021

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 20.08.2020

(45) Опубликовано: 05.04.2021 Бюл. № 10

Адрес для переписки:

644050, г. Омск, пр-кт Мира, 11, ОмГТУ,
Информационно-патентный отдел, Маевский
Дмитрий Павлович

(72) Автор(ы):

Кировская Ираида Алексеевна (RU),
Уманский Илья Юрьевич (RU),
Эккерт Алиса Олеговна (RU),
Эккерт Роберт Владимирович (RU),
Букашкина Татьяна Леонидовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный
технический университет» (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2437087 C2, 20.12.2012. RU
2464554 C1, 20.10.2012. RU 2305830 C1,
10.09.2007. RU 2274853 C1, 20.04.2006. CN
104819998 A, 05.08.2015.

(54) **ДАТЧИК ДИОКСИДА АЗОТА**(57) **Формула изобретения**

Полупроводниковый датчик диоксида азота, содержащий полупроводниковое основание, нанесенное на непроводящую подложку, отличающийся тем, что полупроводниковое основание выполнено из поликристаллической пленки твердого раствора состава $(\text{InAs})_{0,84}(\text{ZnS})_{0,16}$.